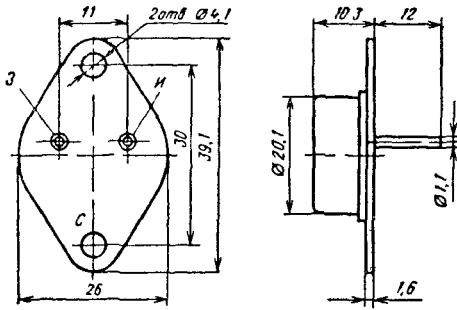


# 2П922 (А, Б)

## 2П922 (А, Б)



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с изолированным затвором и вертикальным индуцированным каналом n-типа. Предназначены для применения в источниках вторичного электропитания, быстродействующих переключающих и импульсных устройствах, а также в стабилизаторах и преобразователях напряжения. Выпускаются в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 20 г.

### Электрические параметры

Сопротивление сток — исток в открытом состоянии при  $U_{зи} = 15$  В,  $I_c = 0,5$  А:

2П922А	0,13*..0,17*..0,2 Ом
2П922Б	0,2* 0,3*..0,4 Ом
Крутизна характеристики при $I_c = 1$ А	1...1,4* 2,1* А/В
Пороговое напряжение при $I_c = 30$ мА	2..5* 8 В
Время включения при $U_{си} = 70$ В, $R_s = 75$ Ом, $R_n = 2$ Ом	40* ..60*..100* нс
Время выключения при $U_{си} = 70$ В, $R_s = 75$ Ом, $R_n = 2$ Ом:	
2П922А	50*..70*..100* нс
2П922Б	40*..70*..100* нс
Емкость сток — исток при $U_{си} = 20$ В, $f = 1$ МГц	300*..380*..600 пФ
Емкость затвор — исток при $U_{зи} = 5$ В, $f = 1$ МГц	1500*..1700*..2000 пФ
Емкость затвор — сток при $U_{зи} = 20$ В, $f = 1$ МГц	350* 600*..1200 пФ
Начальный ток стока при $U_{си} = 100$ В, $U_{зи} = 0$ , не более:	
$T = +25$ °С	2 мА
$T = -60$ °С	2 мА
$T = +125$ °С	4 мА
Ток стока при $U_{си} = 100$ В, $U_{зи} = 15$ В	10 ..11*..13* А

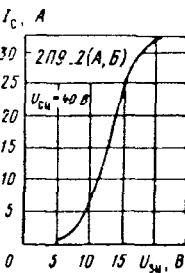
### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток — исток	100 В
Постоянное напряжение затвор — исток <sup>1</sup>	±30 В
Постоянный ток стока при $P_c \leq P_{c, макс}$	10 А
Импульсный ток стока при $t_{и} = 1$ мкс, $Q = 80$ , $P_c \leq P_{c, макс}$	20 А
Постоянная рассеиваемая мощность <sup>2</sup> :	
$T = -60$ °С... $T_n = +35$ °С	75 Вт
$T_n = +125$ °С	15 Вт
Тепловое сопротивление переход — корпус	2 °С/Вт
Температура кристалла	+150 °С
Температура окружающей среды	-60 °С... $T_n = +125$ °С

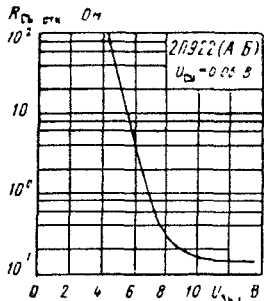
<sup>1</sup> При подаче отрицательного напряжения затвор — исток напряжение сток — исток определяется по формуле  $U_{си, макс} = V_t - 100 - U_{зи}$ .

<sup>2</sup> В диапазоне температур  $T_n = +35...125$  °С мощность снижается линейно.

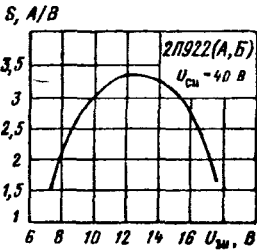
Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре не более +260 °С в течение 5 с.



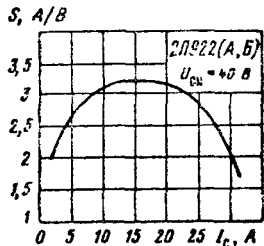
Зависимость тока стока от напряжения затвор — исток



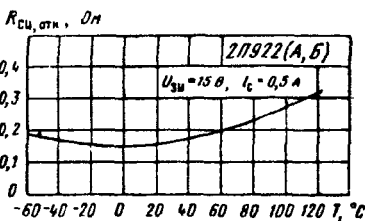
Зависимость сопротивления сток — исток в открытом состоянии от напряжения затвор — исток



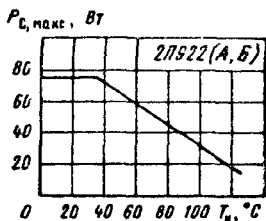
Зависимость крутизны характеристики от напряжения затвор — исток



Зависимость крутизны характеристики от тока стока



Зависимость сопротивления сток — исток в открытом состоянии от температуры



Зависимость допустимой рассеиваемой мощности от температуры